DOI:10.14062/j.issn.0454-5648.1995.06.010

第23卷第6期	硅	酸	盐	学	报		Vol. 23, No. 6
1995年12月	JOURNAL OF	THE CH	HINESE	E CERA	AMIC SO	OCIETY	December,1995

大尺寸氟化铅晶体的生长

沈定中 袁湘龙 张黎星 邓 群 李培俊 殷之文

(中国科学院上海硅酸盐研究所)

摘 要 描述了不用高真空条件,在通常的 Bridgman-Stockbarger 炉中,用高温下的反应方法,消除了原料及生长炉内残 存的 O^{c-}及 OH⁻⁻,生长出优质、大尺寸的 β-PbF₂晶体。在晶体生长时,出现的主要问题是在晶体中的针状结构及开裂,但 可通过控制工艺条件来解决。

关键词 晶体生长,立方相氟化铅,缺陷

1引言

氟化铅 (PbF₂) 晶体不是立方相 (空间群为 $O_{H}^{\circ} - Fm3m$,通常称为 β相) 就是斜方相 (空间群为 $D_{2H}^{\circ} - Pmnb$,通常称为 α相) 结构,在约610K 时,由斜方相转变到立方相^[1]。在常 压下,一般最容易得到 β – PbF₂ (高温相) 晶体,其密度为7.77g/cm³,熔点为855 C,折射率 为1.82。

由于 Pb²⁺较易极化,因此 β – PbF₂晶体是较好的离子导体。转变为超离子态的温度 $T_{e} \approx$ 700K,此时约有40%的氟离子在负离子亚点阵中离开了它们的正常位置,活化能 $E_{a} = (0.64 \pm 0.03) \text{ eV}^{[2]}$ 。

自1989年 Anderson 等人^[3]指出 β - PbF₂晶体是稳定的 Cherenkov 辐射器以来,引起了高能物理学家们的重视。 β - PbF₂晶体的最大特点是密度高、辐射长度短(0.93cm),比最紧密的闪烁体 BGO 还要短15%; Moliere 半径小(2.2cm),比通常使用的 BGO 还小,并且在簇射周围的软粒子,在 PbF₂晶体中基本上不产生 Cherenkov 光,所以实际上 Moliere 半径更小。它是优良的 Cherenkov 材料,是电磁量能器用晶体的优秀候选者,并且在粒子多重性很高的重离子反应中,PbF₂晶体也是很有吸引力的候选者,也适合于在高功率二氧化碳激光系统中作反射器或抗反射器用材料。

生长大尺寸氟化物晶体一般均采用 Bridgman 方法。生长晶体在高真空(约1.33×10⁻⁴ Pa)条件下在石墨坩埚中进行。在生长氟化物晶体时,多采用添加还原剂来净化残留在原料及

667

¹⁹⁹⁴年4月12日收到。国家自然科学基金资助项目。

通讯联系人: 沈定中,中国科学院上海硅酸盐研究所,上海 200050。

感谢本所的李香庭先生提供的电子显微镜照片。感谢本所加工组的周仁明、高焕兴和陈 钢等先生加工测试用样品。

气体中的 O²⁻, OH⁻。由于氟化铅易于分解及与 O²⁻有很强的结合能力, 所以生长氟化物晶体 时常常采用氟化铅作为脱氧剂。这样, 生长大尺寸氟化铅晶体比生长一般氟化物晶体难度更 大。Optovac 等公司均是在通气氛的情况下生长氟化铅晶体的^[4], 可见对气氛与原料中阴离子 的净化是极其重视的。

本工作采用与通常不同的工艺途径,在简化了的工艺条件中生长大尺寸 β – PbF₂(简称 PbF₂) 晶体。

2 晶体生长

用特制的近99.99%的氟化程度较高的α-PbF₂作为生长 PbF₂晶体用原料。在制造原料的 过程中往往会生成含水氟化铅 PbF₂•x(H₂O),其中x值愈小,则原料的氟化程度愈高,原料 质量也愈好。在特制的原料中,虽然 x≪1,但用通常的(约100℃)烘干方法只能脱去原料中 的水份,而无法排除x(H₂O),这样在特制的原料中也存在着 OH⁻,O²⁻的污染。为了消除各种 阴离子的污染,使用了一种代号为703的试剂,使其在晶体生长的高温条件下与阴离子反应, 以达到排除在原料与环境中所有存在的 OH⁻及 O²⁻的目的。

晶体生长使用传统的、通常的、非真空 Bridgman 方法,整个晶体生长过程在密闭状态下进行。炉温控制在1040℃左右,温度控制采用 WJ-702温度控制仪。

文献 [5] 的作者指出,氟化铅晶体的生长速率逐渐地随时间增加,认为 PbF₂晶体的生长 机制基本是受控的体扩散生长机制,其中(100)面的生长较活跃。在我们的 Bridgman 方法中, PbF₂很容易自发成核生长出大单晶,晶体生长速率灵敏地受纵向温度的制约。在热平衡条件 下,晶体的生长速率与温度梯度成正比,较大的生长温度梯度还可以抑制组分的过冷。然而生 长的温度梯度过大,如约50℃/cm,则使生长的晶体在短距离内经受很大的温差,就会造成比 较大的热应力,同时晶体的实际生长速度大大加快,可快至0.5倍以上。综合了各种因素后,选 取约25~30℃/cm 的温度梯度,相应的生长速率约为1.6mm/h。并且在炉子的底部安装了辅 助加热器,其一可提高低温区的温度来达到控制温度梯度的目的;其二利用它对晶体进行后 期退火,以进一步减少晶体中的热应力。

3 结 果

3.1 典型大尺寸晶体的透射率

 β – PbF₂晶体是 Cherenkov 材料,所以通常用光透射率的特性来表征 PbF₂晶体的质量。使用日本岛津生产的 UV –265 Spectrophotometer 测量光透射率,长度超过140mm 的晶体是在插入程长扩展到280mm 的自制测试盒内完成的。

用上述方法生长出了尺寸大于30mm×30mm×200mm 的 PbF₂晶体, 宏观上晶体呈水一样无色透明。无宏观包裹体的典型的光透射率曲线如图1所示, 此晶体尺寸为30mm×30mm×204mm("1晶体)。图中曲线1, 2分别为离晶体端面2cm 处横向光透射率, 其中曲线1为结晶的始端; 曲线2为结晶的末端; 它们的光程 L=30mm。曲线3为纵向透射率曲线, 光程 L=204mm。

3.2 晶体中的宏观缺陷

PbF₂晶体最常见的宏观缺陷发生在晶体的生长后期,在晶体中出现针状结构,在显微镜 下可清楚地看到这些白色的、不透明芯。为了测定这些不透明芯缺陷的性质,在岛津生产的

668

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

度梯度过大等,最后导致晶体开裂。晶体开裂现象很多,如解理、多晶开裂、体内开裂等。在 PbF₂晶体开裂时,无明显解理现象,最常见的现象是产生微裂纹。图4给出了这种微裂纹的显 微照片,图中箭头所指即为微裂纹。这种微裂纹往往先产生在表面,一但研磨加工,经常会使 裂纹层层深入,致使晶体尺寸愈磨愈小,严重影响晶体的成品率。

4 讨 论

4.1 原料纯度对透光率的影响

为了进一步了解原料对晶体透光率的影响,用上试一厂生产的编号为86-05-01的光谱纯 PbF₂原料生长了尺寸为 ¢23mm×54mm 的 PbF₂晶体。其纵向的透射率(*L*=54mm)示于图5 中。由图可见,在测量波段范围内基本无明显吸收峰,仅在290nm 处可以看到一点吸收的痕迹。

但由图1中"1晶体的曲线1,2可见,位于结晶始 端的横向透射率曲线1,在290nm 处有明显的吸收 峰;而位于末端的曲线2,主要在250~350nm 波长范 围内形成了一个吸收带,这里涉及到杂质的分凝问 题。在一维坐标中,晶体内任意一点(Z)的杂质浓度 可表示为:

 $C(Z) = K_0 C_0 (1 - g)^{K_0 - 1}$

式中 K_0 为杂质分凝系数; C_0 为初始杂质浓度;g为凝固分数。

从图1中曲线1,2可知,在 PbF₂晶体中引起约在 290nm 处吸收的杂质的分凝系数 K₀≪1;而引起整个 紫外带吸收的其它杂质的分凝系数小于1,即晶体中 上部的杂质浓度大于底部的杂质浓度。然而图5中的



Fig. 5 Transmission of PbF₂ crystal grown by specpure material

透射率曲线表明:在54mm的透光长度范围内无明显吸收现象,说明提高晶体的质量必须进一步纯化我们特制的 PbF₂原料。

将特制原料93-1与编号为86-05-01的光谱纯料以及一块21cm 长的 PbF₂晶体的两端取样 进行了全分析,结果均列入表1中。

	Та	ble 1 In	npurity n	nass con	tents of	PbF ₂ rav	v materi	ial and c	rystal	$\times 1$	0 4 %
San	nple	Al_2O_3	CaO	SrO	MgO	MnO	BaO	Fe_2O_3	Co_2O_3	NiO	SnO_2
86-05-01		10	20	1	7	1	1	1	5	5	5
93-1		10	30	1	7	1	2	1	5	5	5
93205-6 (crystal)	Bottom	10	20	1	7	1	2	1	5	5	5
	Тор	10	40	1	7	1	4	1	5	5	5

表1 原料与晶体全分析结果

由表1的分析结果表明:特制的 PbF₂原料纯度已接近光谱纯原料,但是 Ca 与 Ba 的含量 670

要比光谱纯高。由此结果可以认为,在290nm 附近的吸收带正是由于 Ca, Ba 等杂质离子含量 高所引起的。

4.2 消除针状结构

当 PbF₂晶体中存在包裹体时,由图3可见明显 影响晶体的透射率。将图3所示晶体切下来的一段 两端抛光后,得出 L=21mm 的晶体透射率结果示 于图6中。由图可见,确实没有增加新的吸收峰,但 整个波段上透光率较低,用 He - Ne 激光通过它时 也可看到明显的散射光,所以这些包裹体实际上在 晶体中起着光散射作用。用电子探针对针状结构内



Fig. 6 Transmission of PbF_2 crystal full of needle-like texture (L=21mm)

的包裹体芯分析结果表明:无明显重于钠元素的其它成份存在,但包裹体内存在着浓度颇高 的亮点又提示着有重元素存在,所以在包裹体内的白色斑点只有可能是 Pb 离子。由于氟与氧 的原子序数仅差1,所以很难分清铅的化合物性质。在晶体生长过程中发现,PbF₂原料的氟化 程度越差越有可能在晶体中形成针状结构缺陷,严重时会使整根晶体中都布满针状结构,所 以可以认为这种包裹体是原料中带入的,它们在生长的高温条件下,是尚未被还原的多余的 铅及其与氧的化合物。

4.3 工艺条件对大尺寸晶体质量的影响

在特制的原料中,包裹体内的杂质可以通过改进工艺条件来减少、以至完全消除宏观的 包裹体。对包裹体影响最灵敏的工艺条件是生长速率与温度梯度。以加工后的长度为20cm的 晶体为准,在实验中的大致关系如表2所示。显而易见,PbF2晶体的质量——透射率与晶体的 工艺条件有着直接的关系。

Table 2 Relationship between thermo-stress, needle-texture and technique conditions							
Downward rate/mm•h ⁻¹	Temperature gradient/ C •cm ^{- 1}	Thermo-stress degree	Needle-texture distribution				
1.0	22	Light, non-split	About 1/3				
	40	Medium, easily split	None				
2.0	22	Rarely split	Full				
	40	Heavy, easiest split	<1/10				

表2 热应力、针状结构与工艺条件的关系

决定晶体成品率的一个重要因素是晶体的机械加工性能。首要问题是减少热应力,消除微裂纹,这与晶体的生长速率、温度梯度又有密切关系,基本统计规律亦示于表2中。

由表2的结果可以看出:梯度增大、下降速率减少对排杂有利,但梯度小,生长慢对减少 晶体中的热应力有利。综合上述因素,并考虑成品率与成本后,取温度梯度为25~30℃/cm,下 降速率为1.6mm/h。

4.4 氟化铅晶体的吸收边

图7给出了文献 [3] 作者所使用的 PbF2晶体的透射率图,该文作者认为 PbF2晶体的吸收 边在280nm。由我们的讨论可知,阳离子杂质的存在主要在紫外区域引起较强的吸收与散射。

671

同时众所周知,在氟化物晶体中其它阴离子的存 在,如 O^{2-} ,会使晶体在紫外区域引起更强烈的吸 收,氧含量超过10⁻⁶量级时,会使晶体着色或呈乳 白色。图7中 PbF₂晶体的吸收边向长波长方向移 动,可能由于某些阳离子与阴离子的同时存在而 引起较大吸收的结果。由我们的结果可知、PbF₂ 晶体的吸收边不应在280nm 处,应该是在245nm 处。

5 结 论

生长大尺寸 PbF₂晶体所使用的方法是通常 的非真空 Bridgman 方法,此方法应用高温下的化 学反应脱氧,达到用简单的 Bridgman 法代替高真 空条件下、设备复杂的 Bridgman 法。使用的原料 是特制的纯度近99.99%氟化较完全的原料。生长 出了无色透明、无包裹体的、宏观完整的、尺寸大





于30mm×30mm×200mm的 PbF₂晶体。晶体中的针状结构实际上是铅及其与氧的化合物有 关的包裹体。大尺寸 PbF₂晶体可以通过控制工艺条件,主要是温度梯度和生长速率,达到提高 质量和减少热应力的目的。同时,确认 β - PbF₂晶体的吸收边为245nm。



1 Robert S R, et al. Phase Diagrams of Ceramists. 1984: 5471

- 2 Kosacki I, Zalibowski K. Polarization phenomena in PbF2 superionic crystal. Phys Status Solidi, 1988; 108 (A): 765
- 3 Anderson D F, et al. Lead fluoride an ultra-compact Cherenkov radivator for EM calorimetry. Nucl Instrum Methods Phys Res, 1990; 290 A: 385
- 4 Lecoq P. News from Optovac on PbF2. 5th Crystal Clear Collabortaion Meeting, 1991; December 12/13
- 5 Norikazu Ohtori, Yuzo Yoshikawa, et al. Crystal growth of transition metal fluorides. Bull Chem Soc Jpn, 1990; 63 (1): 666

LARGE SIZE CRYSTAL GROWTH FOR BETA-LEAD FLUORIDE

Shen Dingzhong Yuan Xianglong Zhang Lixin Deng Qun Li Peijun Yin Zhiwen (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy Sciences)

ABSTRACT Large size beta-PbF₂ crystals of high quality are grown using the ordinary Bridgman-Stockbarger method. O^{2-} and OH^{-} are removed from crystal by means of chemical reaction at high temperature and not under vacuum conditions. As for crystal growth, the main problems are the needle-like texture and crack, which can be resolved through control of technological conditions.

KEY WORDS crystal growth, cubic lead fluoride, defect

Received: April 12, 1994.

Correspondent: Shen Dingzhong, Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy Sciences, Shanghai 200050.